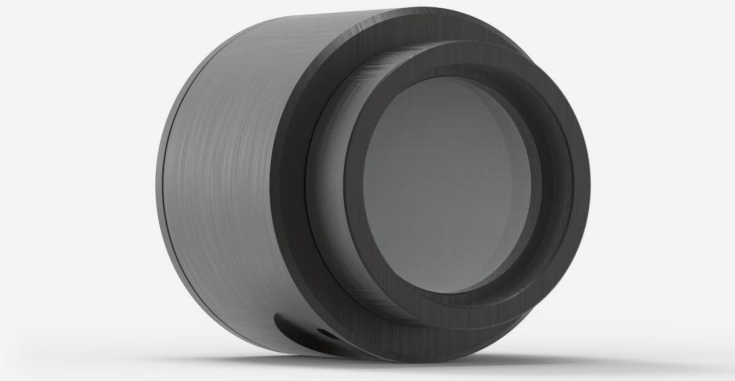


PH20-GE-OD1-D0

光电二极管探测器的激光功率测量高达 300 mW。



产品系列主要特性

- 大光圈
- 硅传感器光圈为10 mm直径
- 3种型号
- 硅 350 - 1080 nm, 高达750 mW
 - 紫外硅 210 - 1080 nm, 高达38 mW
 - 锗 800 - 1650 nm, 高达500 mW
- 衰减器选择
- 高准确度
- 全新PH100-Si-HA大幅降低校准不确定因素
- 准确校准
- 波长选择 1 nm一格
- 智能接口
- 包含所有的校准数据
- 兼容性支架
- [STAND-D-233](#)

规格

测量能力	
最大平均功率 ¹	300 mW
噪声等效功率 ²	600 pW
光谱范围	900 - 1650 nm
典型升起时间	0.2 s
功率校准不确定性 ³	±5.0 % (900 - 1559 nm) ±7.0 % (1560 - 1629 nm) ±10 % (1630 - 1650 nm)
峰值灵敏度	1550 nm
最小重复率 ⁴	1000 Hz
1. 1064 nm, 附有衰减器。查看其他波长的最大功率曲线。 2. 1550 nm。标称值。实际值取决于环境电磁干扰和波长。 3. 附有衰减器。查看用户手册, 了解不使用衰减器校准的不确定性。 4. 详细信息请参阅用户手册。	
损坏阈	
最大平均功率密度	100 W/cm²
物理特性	
孔径	5 mm
吸收器	Ge
尺寸	38.1Ø x 36D mm
重量	0.14 kg
距传感器表面距离	10.5 mm
订购信息	
PH20-Ge-OD1-D0	200874
PH20-Ge-OD1-INT-D0	202796
PH20-Ge-OD1-IDR-D0	203244

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表